	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W1XK018D(单胞) 快恢复二极管	文件编号	临时
		版本号	18-A2-05
		页码	1/2

1 主要用途及主要特点

1.1 主要用途

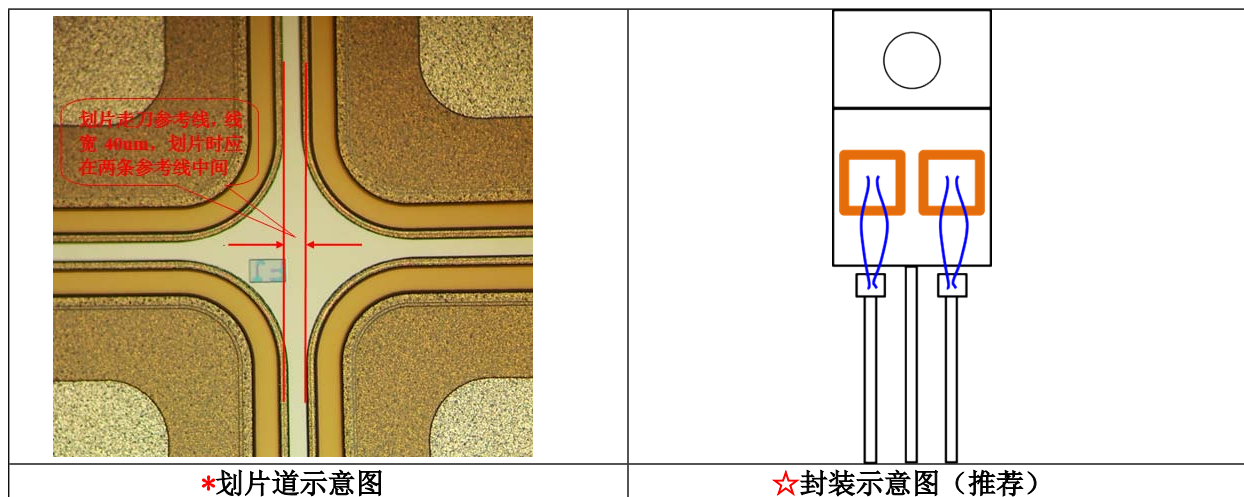
用 W1XK018D 封装的成品管可用于 PFC、UPS、超声清洗机、电焊机等设备上上进行大电流整流。

1.2 主要特点

- 高速开关
- 低功耗
- 高可靠性

2 芯片数据


芯片示意图	芯片尺寸	3.40 mm×3.40 mm		
		133.86 mil×133.86 mil		
	芯片厚度 (μm) (推荐)	220±20		
	▷划片道尺寸 (μm)	40		
	键合区面积 (μm ²)	正面	2760×2760	
		金属	铝	
	正面电极 (阳极)	厚度 (μm)	7.5±1.0	
		背面电极 (阴极) (推	表层金属	银
	硅片直径 (mm)	φ 125		
	装片要求 (推荐)	焊料		
★键合要求 (推荐)	2 根 φ 500 μm 铝线(单			



江阴新顺微电子有限公司

地址：江苏省江阴市长山大道 78 号
电话：(0510) 86851182

网址：Http://www.xs-elec.com
传真：(0510) 86851532

	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W1XK018D(单胞)	文件编号	临时
	快恢复二极管	版本号	18-A2-05
		页码	2/2

3 电特性(在推荐的封装形式、适当的封装条件下)

3.1 极限值

除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	额定值	单位	备注
峰值反向电压	V_{RM}	200	V	推荐封装形式: T0-3P 推荐成品型号: MUR5020PT
正向电流	$I_{F(AV)}$	25 (单胞)	A	
正向浪涌电流(在推荐键合要求)	I_{FSM}	450($t=8.3\text{ms}$, Sine)	A	
结温	T_j	150	$^{\circ}\text{C}$	
贮存温度	T_{stg}	-40~150	$^{\circ}\text{C}$	

3.2 电参数

除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
击穿电压	V_{BR}	$I_R=100\mu\text{A}$	200	—	—	V
反向电流	I_R	$V_R=200\text{V}$	—	0.03	1	μA
正向电压	V_F	$I_F=25\text{A}$	—	0.94	1	V
反向恢复时间	t_{rr}	$I_F=0.5\text{A}$,	—	—	50	ns
总电容	C_{tot}	$V_R=0\text{V}$, $f=1\text{MHz}$	—	610	—	pF

3.3 典型特性曲线

暂无

注意事项:

- 芯片存储条件(推荐): 氮气保护, 温度 $25\pm 5^{\circ}\text{C}$, 湿度 $\leq 45\%$;
- 本产品说明书仅供参考, 不作为合同的一部分, 具体以双方签订的技术协议为准;
- 本产品说明书如有版本变更, 恕不另行告知! 客户在下单前应获取最新版本资料并验证相关信息是否完整和更新;
- 任何半导体产品在特定条件下都有发生失效或故障的可能, 买方有责任在使用新顺产品时遵守安全使用标准并采取安全措施, 以避免潜在的失效或故障风险造成人身伤害或财产损失的发生。

江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号

网址: [Http://www.xs-elec.com](http://www.xs-elec.com)

电话: (0510) 86851182

传真: (0510) 86851532